

Der Transistor GS 111 ist ein Germaniumtransistor in der Bauform A 1 und 10 mm Kappenhöhe.

Dieses Bauelement ist ein mittelschneller Ge-pnp-Schalttransistor mittlerer Leistung.

Statische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ grd}$)

Kollektorrestströme

- $-I_{EBO} \leq 15 \mu\text{A}$ (bei $-U_{EB} = 10\text{ V}$)
- $-I_{CER} \leq 300 \mu\text{A}$ (bei $-U_{CE} = 15\text{ V}$)
- $-I_{CBO} \leq 20 \mu\text{A}$ (bei $-U_{CB} = 20\text{ V}$)
- $-I_{CBO} \leq 15 \mu\text{A}$ (bei $-U_{CB} = 15\text{ V}$)

Restspannung

- $-U_{CE\text{ rest}} = 0,36 \leq 0,55\text{ V}$ (bei $-I_C = 300\text{ mA}$)
- $-U_{CE\text{ sat}} = 0,15 \leq 0,3\text{ V}$ (bei $-I_C = 300\text{ mA}, -I_B = 9,4\text{ mA}$)

Gleichstromverstärkung (bei $-U_{CE} = 0,5\text{ V}, -I_C = 300\text{ mA}$)
(impulsmäßig gemessen)

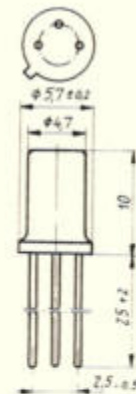
- B_N I 29—55
- II 45—88
- III 72—143
- IV 117—231

Schaltzeitkonstante

$\tau_i \leq 1,2 \mu\text{s}$ (bei $-I_C = 200\text{ mA}, -U_{CE} = 0,5\text{ V}$)



Abmessungen



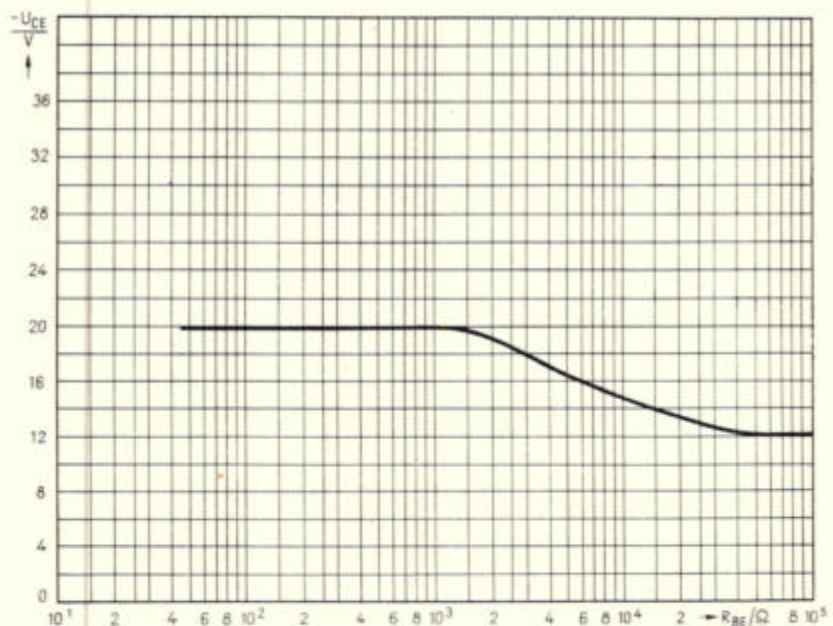
Masse 0,7 g

Grenzwerte (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)

- $-U_{CB} = 20\text{ V}^1)$
- $-U_{EB} = 10\text{ V}$
- $-U_{CER} = 15\text{ V}$ ($R_{BE} = 10\text{ k}\Omega$)
- $-I_C = 200\text{ mA}$
- $-I_C = 300\text{ mA}$
- $-I_E = 220\text{ mA}$
- $-I_E = 330\text{ mA}$
- $P_C = 85\text{ mW}$ (45°C)
- $\vartheta_j = 85^\circ\text{C}$

¹⁾ Siehe Diagramm $-U_{CE} = f(R_{BE})$.

Bestellbezeichnung
für einen Transistor:
Transistor GS 111



Mittlere Kennlinien für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$